

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРОТОКОЛ № 3/21

оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из  
федерального бюджета

г. Москва

24 сентября 2014 г.

**Предмет конкурса:** проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 по приоритетному направлению «Индустрия наносистем» (мероприятие 1.3, 21 очередь) по проектам:

лот 1. Шифр: 2014-14-579-0096 «Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и/или силовых приборов»;

лот 2. Шифр: 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол»;

лот 3. Шифр: 2014-14-579-0094 «Разработка технологии производства и композиции конструкционного материала с повышенной термической и радиационной стойкостью для энергетических установок нового поколения»;

лот 4. Шифр: 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности».

### **На заседании конкурсной комиссии присутствовали:**

Антропов Алексей Петрович

Боков Михаил Владимирович

Грузинова Елена Николаевна

Егоров Сергей Витальевич

Скуратов Алексей Константинович

Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета началась 24.09.2014 по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.

На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило большинство от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсная комиссия, руководствуясь положениями разделов 4.3 "Оценка заявок на участие в конкурсе" и 2.4 "Требования к проекту, представляемому участником конкурса в заявке на участие в конкурсе" Конкурсной документации и учитывая результаты экспертизы заявок на участие в конкурсном отборе, сформировала и утвердила рейтинг заявок, участвующих в конкурсном отборе.

Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсном отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.

В связи с тем, что по лоту 2 Шифр: 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол» и по лоту 4 Шифр: 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности» поступило только по две заявки, а в рамках конкурса предусмотрено заключение не более 2 (двух) Соглашений, конкурсная комиссия приняла решение признать конкурс по данным лотам несостоявшимся.

Сведения о победителях конкурсного отбора приведены в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Участники конкурса, признанные победителями конкурса (приложение №2), должны подписать Соглашения и передать их Заказчику на условиях и в срок, установленных в части 5 "Порядок заключения соглашения" конкурсной документации.

Подписи:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ Грузинова Е.Н.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Боков М.В.

\_\_\_\_\_ Егоров С.В.

\_\_\_\_\_ Скуратов А.К.

30 сентября 2014 г.

Приложение № 1 к протоколу № 3/21 оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Уникальный номер заявки	Заявленная тема работ	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Итоговый балл заявки
<b>Лот 1. № 2014-14-579-0096 «Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и/или силовых приборов»</b>					
1	2014-14-579-0096-001	9192	Разработка технологии получения эпитаксиальных гетероструктур арсенидов галлия и алюминия для нового поколения силовых приборов	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микроструктур Российской академии наук	86
2	2014-14-579-0096-003	3710	Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и силовых приборов	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	84
3	2014-14-579-0096-005	7418	Разработка СВЧ плазменной технологии получения эпитаксиальных карбид кремниевых гетероструктур на кремниевой подложке для нового поколения СВЧ и силовых приборов	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук	78,67
4	2014-14-579-0096-002	0958	Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур АЗВ5 для силовых приборов нового поколения	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	75
5	2014-14-579-0096-004	2587	Разработка технологии хлоридно-гидридной эпитаксии GaN структур на низкодефектных подложках карбида кремния 4Н политипа для высоковольтных мощных PiN -диодов.	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"	73,67
<b>Лот 2. № 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол»</b>					
1	2014-14-579-0095-006	2533	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана"	77,33
2	2014-14-579-0095-007	0886	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол.	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет"	70,67
<b>Лот 3. № 2014-14-579-0094 «Разработка технологии производства и композиции конструкционного материала с повышенной термической и радиационной стойкостью для энергетических установок нового поколения»</b>					

1	2014-14-579-0094-008	5756	Разработка композиции и технологии производства нового термически стабильного и радиационно-стойкого титанового сплава для энергетических установок нового поколения	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"	80
2	2014-14-579-0094-010	3842	Разработка композиции и технологии изготовления высокопрочной, радиационностойкой и теплостойкой стали с оптимизированной наноструктурой для перспективных ядерных реакторов	Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"	74,33
3	2014-14-579-0094-009	2922	Разработка системы легирования и технологии изготовления теплостойкой, радиационностойкой и малоактивирующейся стали с оптимизированной наноструктурой для ядерных реакторов нового поколения	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"	69,33
<b>Лот 4. № 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности»</b>					
1	2014-14-579-0149-012	0705	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности диэлектрических материалов (сапфир, кварцевое стекло) для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	75,33
2	2014-14-579-0149-011	5329	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых и металлических материалов (кремний, медь) для создания нового поколения приборов и устройств для микро- наноэлектроники	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук	64,67

Подписи:

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии

\_\_\_\_\_ Грузинова Е.Н.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Боков М.В.

\_\_\_\_\_ Егоров С.В.

\_\_\_\_\_ Скуратов А.К.

30 сентября 2014 г.

Приложение № 2 к протоколу № 3/21 оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

### Сведения о победителях конкурса

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Уникальный номер заявки	Заявленная тема работ	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Почтовый адрес	Запрашиваемый объем финансирования (млн. руб.)			
						Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.
<b>Лот 1. № 2014-14-579-0096 «Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и/или силовых приборов»</b>									
1	2014-14-579-0096-001	9192	Разработка технологии получения эпитаксиальных гетероструктур арсенидов галлия и алюминия для нового поколения силовых приборов	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микроструктур Российской академии наук	603950, Приволжский федеральный округ, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ГСП-105	40	25	7,5	7,5
2	2014-14-579-0096-003	3710	Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и силовых приборов	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	115409, Центральный федеральный округ, Москва г, ш. Каширское, дом 31	40	25	7,5	7,5
<b>Лот 2. № 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения ком-бинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол.»</b>									
1	2014-14-579-0095-006	2533	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана"	105005, Центральный федеральный округ, Москва г, ул. Бауманская 2-я, дом 5,стр.1	35	15	10	10
2	2014-14-579-0095-007	0886	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол.	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет"	308015, Центральный федеральный округ, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Победы, дом 85	35	15	10	10
<b>Лот 3. № 2014-14-579-0094 «Разработка технологии производства и композиции конструкционного материала с повышенной термической и радиационной стойкостью для энергетических установок нового поколения»</b>									

1	2014-14-579-0094-008	5756	Разработка композиции и технологии производства нового термически стабильного и радиационно-стойкого титанового сплава для энергетических установок нового поколения	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"	191015, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург г, ул. Шпалерная, дом 49	40	25	7,5	7,5
2	2014-14-579-0094-010	3842	Разработка композиции и технологии изготовления высокопрочной, радиационнстойкой и теплостойкой стали с оптимизированной наноструктурой для перспективных ядерных реакторов	Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"	115088, Центральный федеральный округ, Москва г, ул. Шарикоподшипниковская, дом 4	40	25	7,5	7,5
<b>Лот 4. № 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности»</b>									
1	2014-14-579-0149-012	0705	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности диэлектрических материалов (сапфир, кварцевое стекло) для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	115409, Центральный федеральный округ, Москва г, ш. Каширское, дом 31	40	25	7,5	7,5
2	2014-14-579-0149-011	5329	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых и металлических материалов (кремний, медь) для создания нового поколения приборов и устройств для микро- наноэлектроники	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук	142432, Центральный федеральный округ, Московская обл., г. Городской округ Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, дом 6	40	25	7,5	7,5

Подписи:

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии

\_\_\_\_\_ Грузинова Е.Н.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Боков М.В.

\_\_\_\_\_ Егоров С.В.

\_\_\_\_\_ Скуратов А.К.

30 сентября 2014 г.